

Title (en)
METHOD AND APPARATUS FOR GROWING SINGLE CRYSTAL BODIES.

Title (de)
VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM WACHSEN VON MONOKRISTALLEN.

Title (fr)
PROCEDE ET APPAREIL POUR LA CROISSANCE DE MONOCRISTAUX.

Publication
EP 0221051 A1 19870513 (EN)

Application
EP 85902308 A 19850416

Priority
US 8500697 W 19850416

Abstract (en)
[origin: WO8606109A1] A method and apparatus for use in growing single crystal bodies. The method includes directional solidification techniques in which a boule is pulled from a thermally controlled melt on a substantially continuous basis while the melt is continuously replenished from feed stock. The process is carried out in a vacuum and with or without a melt overflow. The apparatus includes a shallow through crucible (26), multiple pulling zones (40) and continuous silicon feed means (24) controlled by the melt level.

Abstract (fr)
Procédé et appareil destiné à être utilisé dans la croissance de monocristaux. Le procédé comprend des techniques de solidification directionnelle dans lesquelles une pierre synthétique est extraite d'une fonte thermocommandée sur une base quasiment continue, alors que la fonte est continuellement alimentée par la charge. Le procédé est exécuté sous vide d'air, avec ou sans débordement de fonte. L'appareil comprend un creuset d'écoulement (26) peu profond, plusieurs zones de tirage (40) et un dispositif d'alimentation continue en silicium (24) commandé par le niveau de la fonte.

IPC 1-7
C30B 15/04

IPC 8 full level
C30B 15/00 (2006.01); **C30B 15/02** (2006.01); **C30B 29/66** (2006.01)

CPC (source: EP)
C30B 15/005 (2013.01); **C30B 15/02** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 8606109A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 8606109 A1 19861023; DK 606986 A 19861216; DK 606986 D0 19861216; EP 0221051 A1 19870513; FI 865130 A0 19861216; FI 865130 A 19861216

DOCDB simple family (application)
US 8500697 W 19850416; DK 606986 A 19861216; EP 85902308 A 19850416; FI 865130 A 19861216